

公開シンポジウム

省エネルギー社会の実現に資する 次世代半導体研究開発

— 青からパワーへ 未来への挑戦 —

日本発の窒化ガリウム (GaN) による青色 LED は、省エネルギーな明かりを世界中に届けました。世界全体で抜本的な CO₂ 削減が喫緊の課題となる中、GaN の優れた物性を利用した、あらゆる電気機器に入っている電力変換デバイス (パワーデバイス) の省エネ化が切り札となります。そこで、文部科学省ではこの度、「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」を立ち上げ、GaN 研究の第一人者である天野教授を中心に産学官を結集したプロジェクトを開始しました。本シンポジウムでは、次世代半導体による省エネ社会の実現及び産業競争力の強化に向け、これまでの日本の半導体研究開発の経験も踏まえ、総合的な討論を行います。

平成28年

5/18

水

14:00-17:00

事前申込制・参加無料



会場：学術総合センター一橋講堂
(東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 1-2)

申込み
方法

下記ウェブサイトにてお申し込み下さい (先着順・定員 500 名)

<http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/event/detail/0003377.html>

プログラム

- (1) 開会挨拶 文部科学省
- (2) 来賓挨拶
- (3) 「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」について
・事業趣旨
谷口研二プログラムディレクター (大阪大学)
・GaN による省エネルギー社会への貢献と事業構想
天野浩教授 (名古屋大学未来材料・システム研究所)
- (4) パネルディスカッション「GaN 等の次世代半導体の実用化に向けて」
谷口研二プログラムディレクター (大阪大学)
上田大助プログラムオフィサー (京都工芸繊維大学)
松本功プログラムオフィサー (大陽日酸株式会社)
天野浩教授 (名古屋大学未来材料・システム研究所) 他
- (5) 閉会挨拶 文部科学省



中核拠点研究代表者 天野浩教授
(2014 年ノーベル物理学賞受賞)

お問い合わせ

名古屋大学 シンポジウム担当

TEL : 052-747-6584 FAX : 052-789-2041 E-MAIL : gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp

主催：文部科学省